

## Ultrasoft Recovery Rectifier Diode

### PRODUCT APPLICATIONS

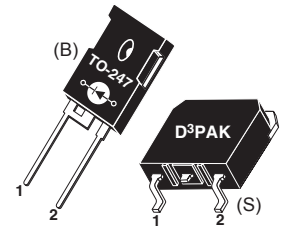
- Anti-Parallel Diode
  - Switchmode Power Supply
  - Inverters
- Applications
  - Induction Heating
- Resonant Mode Circuits
  - ZVS and ZCS Topologies
  - Phase Shifted Bridge

### PRODUCT FEATURES

- Ultrasoft Recovery Times ( $t_{rr}$ )
- Popular TO-247 Package or Surface Mount D<sup>3</sup>PAK Package
- Ultra Low Forward Voltage
- Low Leakage Current

### PRODUCT BENEFITS

- Soft Switching - High  $Q_{rr}$
- Low Noise Switching
  - Reduced Ringing
- Higher Reliability Systems
- Minimizes or eliminates snubber



1 - Cathode  
 2 - Anode  
 Back of Case - Cathode

### MAXIMUM RATINGS

All Ratings:  $T_C = 25^\circ\text{C}$  unless otherwise specified.

Symbol	Characteristic / Test Conditions	Ratings	Unit
$V_R$	Maximum D.C. Reverse Voltage	600	Volts
$V_{RRM}$	Maximum Peak Repetitive Reverse Voltage		
$V_{RWM}$	Maximum Working Peak Reverse Voltage		
$I_{F(AV)}$	Maximum Average Forward current <sup>①</sup> ( $T_C = 124^\circ\text{C}$ , Duty Cycle = 0.5)	100	Amps
$I_{F(RMS)}$	RMS Forward Current (Square wave, 50% duty)	131	
$I_{FSM}$	Non-Repetitive Forward Surge Current ( $T_J = 45^\circ\text{C}$ , 8.3 ms)	600	
$T_J, T_{STG}$	Operating and Storage Junction Temperature Range	-55 to 175	$^\circ\text{C}$
$T_L$	Lead Temperature for 10 Seconds	300	

### STATIC ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Symbol	Characteristic / Test Conditions	Min	Typ	Max	Unit	
$V_F$	Forward Voltage		$I_F = 100\text{A}$	1.25	1.6	Volts
			$I_F = 200\text{A}$	2.0		
			$I_F = 100\text{A}, T_J = 25^\circ\text{C}$	1.28		
$I_{RM}$	Maximum Reverse Leakage Current		$V_R = 600\text{V}$		25	$\mu\text{A}$
			$V_R = 600\text{V}, T_J = 125^\circ\text{C}$		250	
$C_T$	Junction Capacitance, $V_R = 200\text{V}$		97		pF	

## DYNAMIC CHARACTERISTICS

APT100DL60B\_S(G)

Symbol	Characteristic / Test Conditions	Min	Typ	Max	Unit
$t_{rr}$	Reverse Recovery Time $I_F = 1A, di_F/dt = -100A/\mu s, V_R = 30V, T_J = 25^\circ C$		110		ns
$t_{rr}$	Reverse Recovery Time		487		
$Q_{rr}$	Reverse Recovery Charge		2328		nC
$I_{RRM}$	Maximum Reverse Recovery Current		11		Amps
$t_{rr}$	Reverse Recovery Time		716		ns
$Q_{rr}$	Reverse Recovery Charge		5954		nC
$I_{RRM}$	Maximum Reverse Recovery Current		18		Amps
$t_{rr}$	Reverse Recovery Time		333		ns
$Q_{rr}$	Reverse Recovery Charge		10002		nC
$I_{RRM}$	Maximum Reverse Recovery Current		49		Amps

## THERMAL AND MECHANICAL CHARACTERISTICS

Symbol	Characteristic / Test Conditions	Min	Typ	Max	Unit
$R_{\theta JC}$	Junction-to-Case Thermal Resistance			0.34	$^\circ C/W$
$W_T$	Package Weight		0.22		oz
			5.9		g
Torque	Maximum Mounting Torque			10	lb-in
				1.1	N-m

① Continuous current limited by package lead temperature.

Microsemi reserves the right to change, without notice, the specifications and information contained herein.

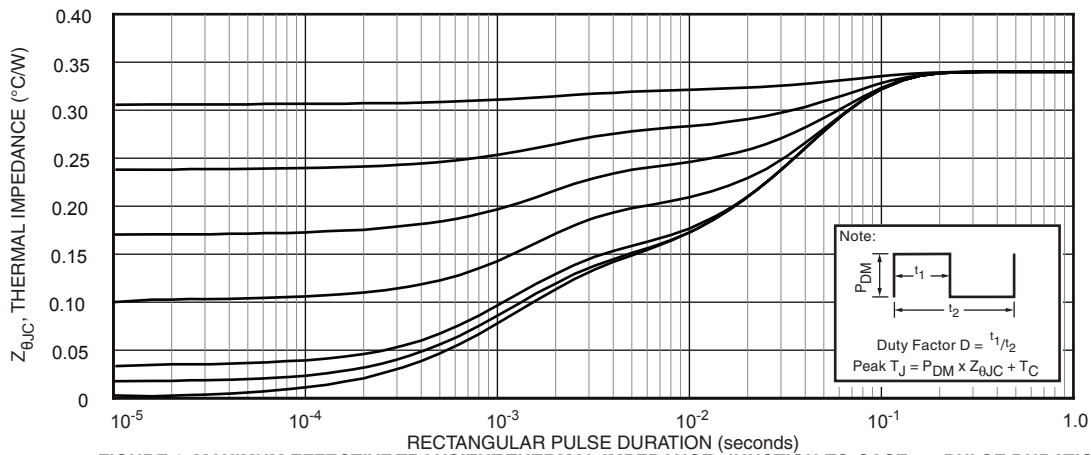


FIGURE 1. MAXIMUM EFFECTIVE TRANSIENT THERMAL IMPEDANCE, JUNCTION-TO-CASE vs. PULSE DURATION

# TYPICAL PERFORMANCE CURVES

APT100DL60B\_S(G)

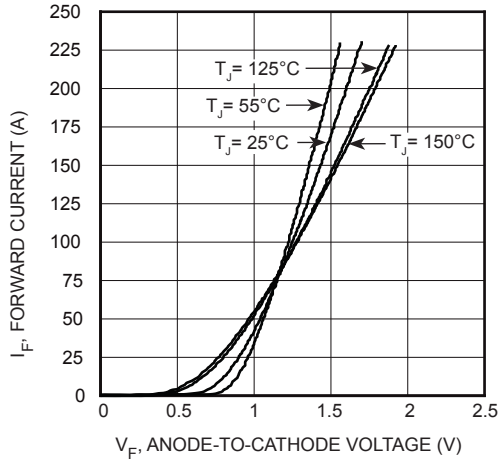


FIGURE 2, Forward Current vs. Forward Voltage

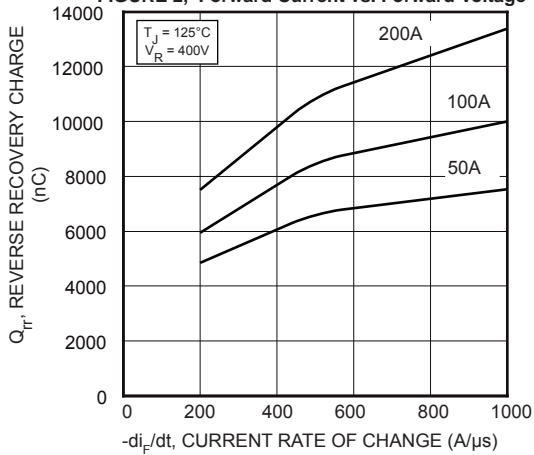


FIGURE 4, Reverse Recovery Charge vs. Current Rate of Change

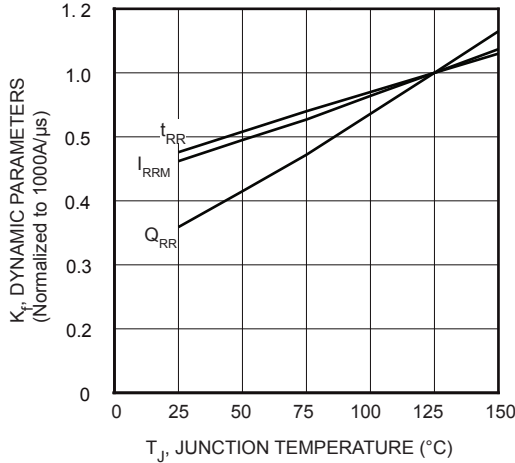


FIGURE 6, Dynamic Parameters vs. Junction Temperature

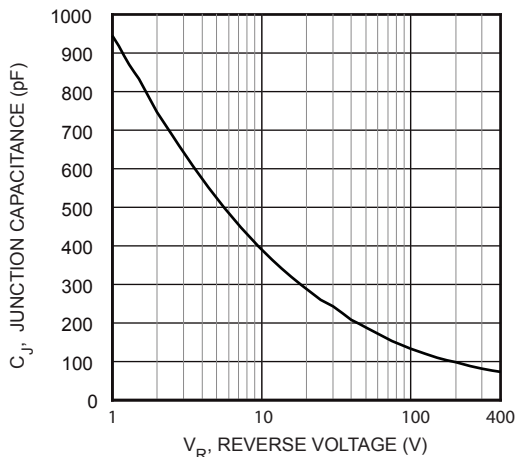


FIGURE 8, Junction Capacitance vs. Reverse Voltage

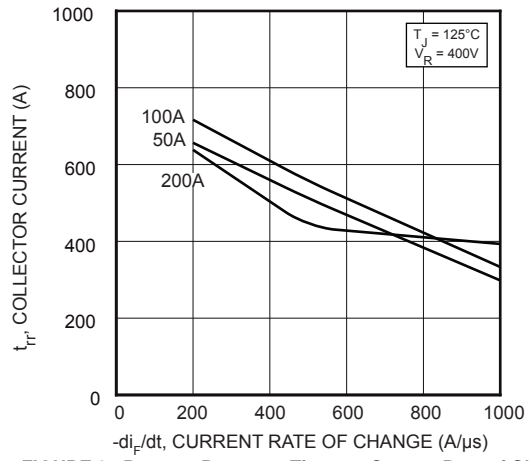


FIGURE 3, Reverse Recovery Time vs. Current Rate of Change

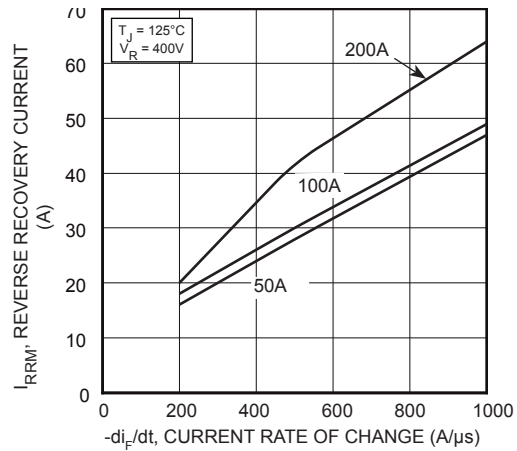


FIGURE 5, Reverse Recovery Current vs. Current Rate of Change

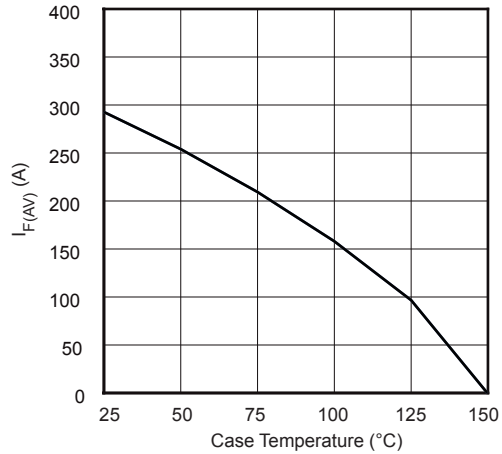


FIGURE 7, Maximum Average Forward Current vs. Case Temperature

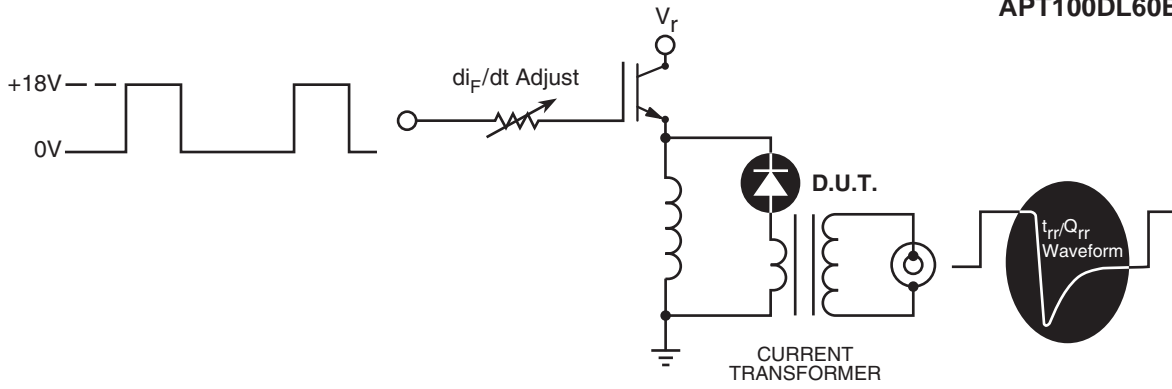


Figure 9. Diode Test Circuit

- 1  $I_F$  - Forward Conduction Current
- 2  $di_F/dt$  - Rate of Diode Current Change Through Zero Crossing.
- 3  $I_{RRM}$  - Maximum Reverse Recovery Current.
- 4  $t_{rr}$  - Reverse Recovery Time, measured from zero crossing where diode current goes from positive to negative, to the point at which the straight line through  $I_{RRM}$  and  $0.25 \cdot I_{RRM}$  passes through zero.
- 5  $Q_{rr}$  - Area Under the Curve Defined by  $I_{RRM}$  and  $t_{rr}$ .
- 6  $di_M/dt$  - Maximum Rate of Current Increase During the Trailing Portion of  $t_{rr}$ .

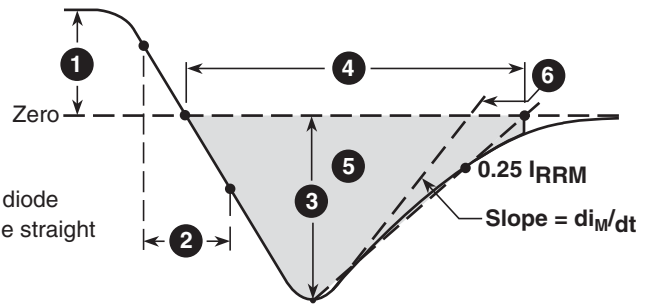
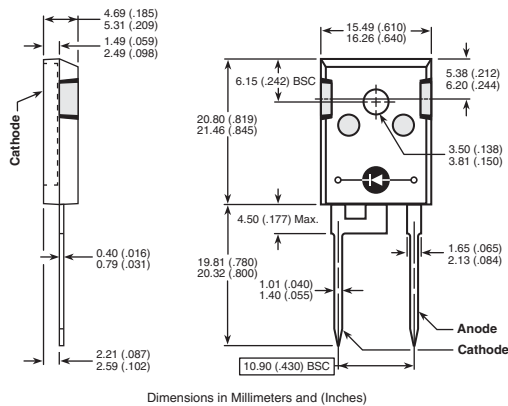


Figure 10, Diode Reverse Recovery Waveform and Definitions

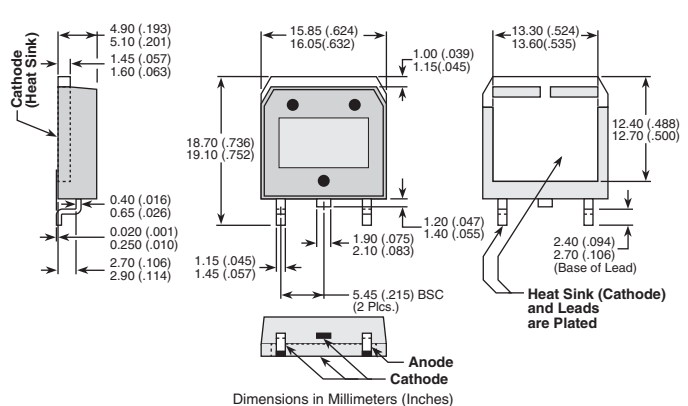
### TO-247 Package Outline

e1 SAC: Tin, Silver, Copper



### D<sup>3</sup>PAK Package Outline

e1 100% Sn





Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.